





# RÖUNICA APLICADA



## Aula 3

## **Bibliografia Básica**

#### Link Biblioteca:

http://187.86.214.60/pergamum/biblioteca/index.php?id=ANHAN

Instrumentação industrial conceitos, aplicações e análises - 7 / 2010 - ( E-book )

onder

FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação industrial : conceitos, aplicações e análises. 7. São Paulo Erica 2010 1 recurso online ISBN 9788536505190.

Exemplares | Marc

- 1. FIALHO, Arivelto B. Instrumentação Industrial: conceitos, aplicações e análises. 3ª edição. São Paulo: Érica, 2010. (E-Book)
- 2. CRUZ, Eduardo Cesar Alves. **Eletrônica Aplicada**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Érica, 2013. (11 exemplares)
- 3. BOYLESTAD, Robert L. NASHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos** e **Teoria de Circuitos.** 12ª edição. São Paulo: Pearson, 2013. (17 exemplares)



#### **Diodo Semicondutor**

## **Processo de Dopagem dos Semicondutores**

Dopagem: processo utilizado para a adição de outros elementos químicos de forma reduzida à algum elemento, como o silício.

#### **Semicondutor Tipo P**

Portadores majoritários:

p+

Si Si Si Lacuna
Si Alo Si Atomo de Alumínio

Portadores minoritários:

e-

Figura 1.12 - Geração de lacuna por dopagem trivalente.

kroton<sup>K</sup>



## Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## **Processo de Dopagem dos Semicondutores**

Dopagem: processo utilizado para a adição de outros elementos químicos de forma reduzida à algum elemento, como o silício.

#### **Semicondutor Tipo N**

Portadores majoritários:

e-

Si Si Si Elétron Excedents

Atomo de Fósforo

Figura 1.13 - Geração de elétron livre

Portadores minoritários:

p+

Figura 1.13 - Geração de elétron livre por dopagem pentavalente.

kroton<sup>⊀</sup>



#### **Diodo Semicondutor**

## Junção PN- Diodo

Cristal único da união de um semicondutor P com um N. Desta forma, temos um diodo de junção ou ainda diodo.

#### Semicondutor Tipo N + Semicondutor Tipo P:

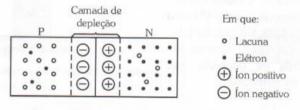


Figura 1.14 - Junção PN e a barreira de potencial.

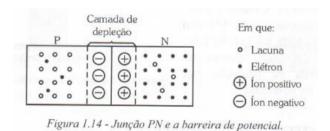




# Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## Junção PN- Diodo



Processo de difusão de cargas com deslocamento de cargas de regiões de elevada concentração para regiões de baixa concentração.



#### **Diodo Semicondutor**

#### Junção PN- Diodo

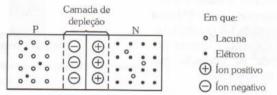


Figura 1.14 - Junção PN e a barreira de potencial.

Nesse processo, os e- do lado N vão para o P, esses e- criam regiões de íons positivos (cátions) próximos a junção.

No lado P, quando os elétrons ocupam as lacunas que também se encontram próximas da junção (recombinação elétron- lacuna), eles criam íons negativos (ânions).





## Aula 3

#### **Diodo Semicondutor**

#### Junção PN- Diodo

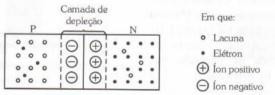


Figura 1.14 - Junção PN e a barreira de potencial.

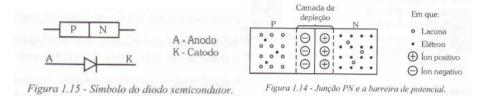
A região com a formação dos íons, passa a ter características especiais pois ficam livres de portadores de carga (elétrons e lacunas), e é chamada de camada de deplecão, pois formam uma barreira de potencial.

À temperatura ambiente, a barreira de potencial vale aproximadamente 0,6V para o semicondutor silício e aproximadamente 0,3V para o germânio.



#### **Diodo Semicondutor**

## Junção PN- Diodo



Terminal P- ânions- íons negativos – ânodo;

Terminal N- cátions- íons positivos- cátodo



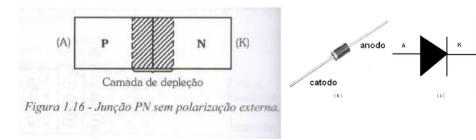


# Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## Polarização do Diodo

## Sem estar polarizado:

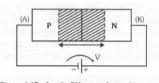




#### **Diodo Semicondutor**

## Polarização do Diodo

**Diodo Reversamente Polarizado:** comporta-se como uma resistência muito alta, ou seja, circuito aberto.



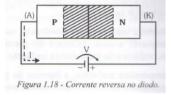


Figura 1.17 - Junção PN com polarização reversa.

Atua de forma a impedir a circulação de portadores majoritários de carga através da junção. Surge corrente reversa.

kroton



11



# Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## Polarização do Diodo

**Diodo Diretamente Polarizado:** comporta-se como uma resistência muito baixa, ou seja, curto-circuito.

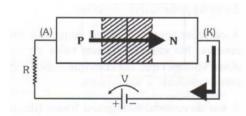


Figura 1.19 - Junção PN com polarização direta.

kroton<sup>⊀</sup>



#### **Diodo Semicondutor**

#### Curva Característica do Diodo

No primeiro quadrante: I e V positivas- polarização direta; No terceiro quadrante: I e V negativas- polarização reversa.



de um diodo de silício.

IF- forward current- corrente direta máxima!

13





# Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## **Curva Característica do Diodo**

**Exercício:** Esboce a curva característica do diodo 1N4004, sabendo que ele é de silício e que suas principais especificações, obtidas em um manual são:

- I<sub>FMÁX</sub>= 1A;
- V<sub>RMÁX</sub>= 400V

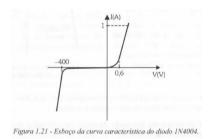


#### **Diodo Semicondutor**

## Curva Característica do Diodo

**Exercício:** Esboce a curva característica do diodo 1N4004, sabendo que ele é de silício e que suas principais especificações, obtidas em um manual são:

- I<sub>FMÁX</sub>= 1A;
- V<sub>RMÁX</sub>= 400V



5





# Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## Reta de Carga do Diodo

Determinação analítica do ponto de operação, por meio da reta de carga.

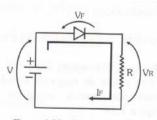
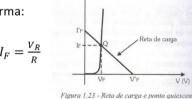


Figura 1.22 - Polarização direta de um diodo.

V > 0.6V; Logo  $V_R = V - V_F$ 

Desta forma:



6 kroton

8



#### **Diodo Semicondutor**

## Reta de Carga do Diodo

Determinação gráfica do ponto de operação, por meio da reta de carga.

Reta: traçar dois pontos, escolhe-se os pontos com grandezas nulas.
 Primeiro ponto- Diodo em curto: corrente máxima (I'<sub>F</sub>)

 $I'_F = \frac{V}{R}$  Diodo em curto!







## Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## Reta de Carga do Diodo

Determinação gráfica do ponto de operação, por meio da reta de carga.

 Reta: traçar dois pontos, escolhe-se os pontos com grandezas nulas Segundo ponto - Diodo em aberto: tensão máxima (V'<sub>F</sub>)

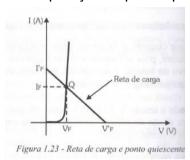
 $V_R = V$  Diodo aberto!



#### **Diodo Semicondutor**

## Reta de Carga do Diodo

De posse destes dois valores, pode-se construir a reta de carga. O ponto Q entre a reta de carga e a curva característica do diodo é o ponto de operação ou ponto quiescente.



19



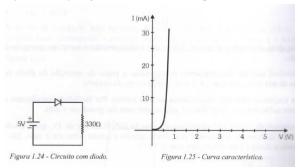


## Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

**Exercício:** Considere o circuito e a curva característica do diodo:

- a) Determine o ponto de operação do diodo de forma analítica.
- b) Determine o ponto de operação do diodo de forma gráfica.





#### **Diodo Semicondutor**

**Exercício:** Considere o circuito e a curva característica do diodo:

a) Determine o ponto de operação do diodo de forma analítica.

Solução:

 $V_{F=} 0.6V;$ 

V<sub>R=</sub> 4,4V;

 $I_F = 13,33 \text{mA}$ 

kroton

21



# Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

**Exercício:** Considere o circuito e a curva característica do diodo:

b) Determine o ponto de operação do diodo de forma gráfica.

Primeiramente, calcule os dois pontos para traçar a reta de carga:

- Corrente máxima no diodo:  $I'F = \frac{V}{R} = \frac{5}{330} \Rightarrow I'F \cong 15 \text{mA}$
- Tensão máxima no diodo:  $V'_F = V \Rightarrow V'_F = 5V$

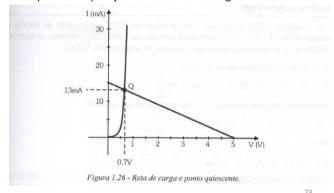
kroton<sup>⊀</sup>



#### **Diodo Semicondutor**

**Exercício:** Considere o circuito e a curva característica do diodo:

b) Determine o ponto de operação do diodo de forma gráfica.







# Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## Efeito da Temperatura no Diodo:

Sofre influência da Temperatura. A temperatura máxima do Si está por volta

de 150ºC e Ge (100ºC)

Para cada aumento de 1ºC na temperatura, A tensão direta no diodo diminui cerca de 2,5mV, ou seja, a taxa de variação da tensão em função da temperatura é de -2,5 mV/ºC

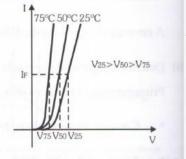


Figura 1.27 - Efeito da temperatura no diodo.



#### **Diodo Semicondutor**

#### Exercício:

Um diodo de silício apresenta, à temperatura de 25ºC, uma queda de tensão no sentido direto de **VF1=0,6V** com uma corrente de 12mA. Se a corrente se mantiver constante, qual será a tensão direta resultante na temperatura 115ºC?

Resposta: VF2=0,375V.

2





# Aula 3

## **Diodo Semicondutor**

## Lista 1 de Exercícios:

Realizar os exercícios propostos: 1.1 à 1.3 página 33 e 1.4 à 1.5 página 34. Enunciado + respostas à mão, individual e na folha padrão.

Entrega: 18/03/2015 até as 20hs.























